









	<p>Hersteller-Teilenummer: STD130N6F7</p>
	<p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 60V 80A DPAK</p>
	<p>Datenblätter:  STD130N6F7.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 17622 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	STD130N6F7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 60V 80A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17622 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 80A (Tc) 134W (Tc) Surface Mount
Serie	STripFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	134W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	497-17305-2

STD130N6F7 ist neu im Original, Suche STD130N6F7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD130N6F7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STD130N6F7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>STD130GK16B Sirectifier IGBT Modules</p>	 <p>STD13N50DM2AG STMicroelectronics POWER TRANSISTORS</p>	 <p>STD130N6F7 ST ST TO-252</p>	 <p>STD130GK14B Sirectifier IGBT Modules</p>
 <p>STD13N60M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 11A DPAK</p>	 <p>STD134N4F7AG STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 40V 80A DPAK</p>	 <p>STD130GK18 SIRECTIFIER IGBT Modules</p>	 <p>STD130N4F6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ STD12NE06	↔ STD12NE06L-TR	⇒ STD12NE06LT4	D STD12NE06T4	↔ STD12NF06-1
⊣ STD12NF06L-1	⊛ STD12NF06LT4	D STD12NF06T4	⇒ STD12NM50N	↔ STD13003
⊛ STD13003T4	⊣ STD13005F	⊛ STD13005FB	↔ STD13005I	↔ STD13007
D STD130GK08	⊛ STD130GK08B	⊣ STD130GK12	⊛ STD130GK12B	↔ STD130GK14
⇒ STD130GK14B	↔ STD130GK16	⊛ STD130GK16B	⊣ STD130GK18	↔ STD130N4F6AG
↔ STD130N6F7	⇒ STD134N4F7AG	D STD13N60M2	⊛ STD13N65M2	⊣ STD13NM60N
⊛ STD13NM60NT4	D STD140N6F7	⇒ STD14NM50N	↔ STD14NM60N	↔ STD1501-ADJM-TRG
⊣ STD150N3LLH6	⊛ STD150NH02	↔ STD150NH02L	⇒ STD150NH02L-1	↔ STD150NH02LT4
⊛ STD155N3H6	⊣ STD155N3LH6	⊛ STD15N06L	D STD15N65M5	↔ STD15NF06L
↔ STD15NF10	⊛ STD15NF10T4	⊣ STD15P6F6AG	⊛ STD160-1	↔ STD165GK08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited